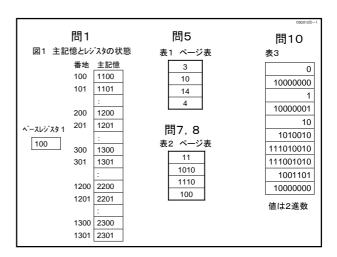
基礎OS① メモリの管理(2)

2012年度(3時限目)



問1 MMU あるシステムにおいて、「LOAD 1,100,ebx」は、再配置レジスタ1(ベースレ ジスタ1)を用いて、論理アドレス100の内容を汎用レジスタebx(にロードする命令である。スライド(เดาวา/เล)図1の状態で、この命令を実行すると、汎用レ ジスタebxの値は幾つになるか. [数間のみを半角数字でRA](基本情報 平成23年 春期) 答 1200 プログラムロード先の 先頭アドレスを設定 再配置レジスタ1(ベースレジスタ1) 論理記憶 物理記憶(主記憶) 論理アドレス(プロク゚ラムの処理) 1100 1101 物理アドレス: 1100 論理アドレス: 100 101 100+100=200 OAD 1,200 ea: MMU OAD 1,100 eb 100 101 201 300 301 300 201

問2, 問3 ページング

問2 下記の①, ②に対応する語句を記入せよ. (①, ②の順に金角の「, 」で区切り金角文字で記入、途中に空台

ページングは、(①) 記憶を枠と呼ばれる固定長(2のn乗)のブロックに分割し、(②) 記憶を枠と同じ大きさのページに分割する. 枠はページを収容するためのエリアである.

答 物理, 論理

問3 下記の③、④に対応する語句を記入せよ。 ③ ④の眼に食舟の「, 寸区域別金角文字で配入 途中に空白があった」「」は気着」に砂をは、はグランテスを開いた。

ページングでは、論理アドレスを上位のページ番号(=p)と下位の変位(=d) に分ける.(③)には、各ページに対応する枠番号(=f)が保持されており、これを変位(=d)を結合して物理アドレスとなる.このような形の動的再配置を行うことにより、割当て解放を繰り返すことにより、小さな穴が発生する(④)という問題が無い。

答 ページ表,外部断片化

p.126, 127 断片化(フラグメンテーション)と詰め直し <mark>陽斷片化</mark>(External Fragmentation) 領域の割当て 解放で小さな穴ができること os os タルでは要求を満足する大きさがあるが、不連続なの 40 40 詰 で使えない。 P5 P5 直 90 90 詰直し(compaction) し 100 外部断片化した穴をまとめて大きな穴にする。 詰直しは、動的再配置を行うときのみ可能 P4 P4 (静的再配置を行う場合は不可能) 160 170 P3 190 内部断片化(Internal Fragmentation) 200 実際には、一定の大きさのブロック単位で割り当てるため、最後に余りが出ること. РЗ 230 割当て領域 この余り領域は使用されない 250 250 ブロック1 使用する部分 断片60 ブロック2 使用しない部分 割当て解放の 外部断片化

重要:ページングの特徴

- 記憶(メモリ)を<mark>論理記憶と物理記憶に分けて考える</mark>←重要な考え方
 - 論理記憶が真の記憶, 物理記憶(主記憶上の枠) は資源(注1)
 - 連続している<mark>論理記憶を</mark>枠と同じ大きさの<mark>ページ</mark>に分割
 - 割り当てる<mark>物理記憶(枠)は不連続</mark>でも良い^(注2)
 - その結果, 外部断片化が無い(内部断片化は有り(注3))
 - 必要数の空き枠があれば良い(連続穴の検索不要)
- ページ表に枠番号とページ番号の対応関係を設定
 - ページ表を使って、実行時に論理アドレスを物理アドレスに変換
 - ページ表はプロセス毎に必要(主記憶上のPCBに格納)
- 注1:論理記憶による計算のために、物理記憶(主記憶)を資源として使用する
- 注2:更には、物理記憶が全て割り当てられる必要も無い
- 注3:物理記憶をページサイス・単位で割り当てられる。 論理記憶の大きさは任意であるので、 最後のページ 枠には、 未使用部分ができる.

1

